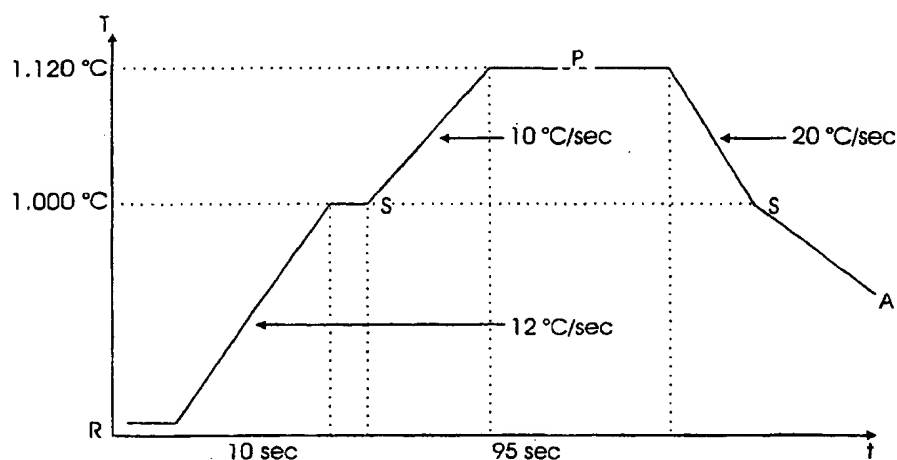


PCTWELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales BüroINTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation ⁷ : H01L 21/316		A1	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 00/52748
			(43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 8. September 2000 (08.09.00)
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE00/00655			(81) Bestimmungsstaaten: CN, JP, KR, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).
(22) Internationales Anmeldedatum: 2. März 2000 (02.03.00)			
(30) Prioritätsdaten: 199 09 564.7 4. März 1999 (04.03.99) DE			
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): INFI- NEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; St.-Martin-Strasse 53, D-81541 München (DE).			
(72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KEGEL, Wilhelm [DE/DE]; Bergerstrasse 1, D-01465 Langenbrück (DE). SCHUSTER, Thomas [DE/DE]; Ewald-Kluge-Strasse 60, D-01108 Dres- den (DE).			
(74) Gemeinsamer Vertreter: INFINEON TECHNOLOGIES AG; Zedlitz, Peter, Postfach 22 13 17, D-80503 München (DE).			Veröffentlicht <i>Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.</i>

(54) Title: METHOD FOR IMPROVING THERMAL PROCESS STEPS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR VERBESSERUNG THERMISCHER PROZESSSCHRITTE



(57) Abstract

The invention relates to a method for improving thermal process steps, especially in RTP processes during various oxidation processes. The inventive method is characterized in that the wafer is heated with a heating rate of approximately 12 °C/sec until a stabilization step is reached at a temperature of 120 °C below the process temperature and, afterwards, is heated with a heating rate of 10 °C/sec until a process temperature is obtained. The wafer is then cooled with a lower cooling rate of approximately 20 °C/sec down to the exit temperature.